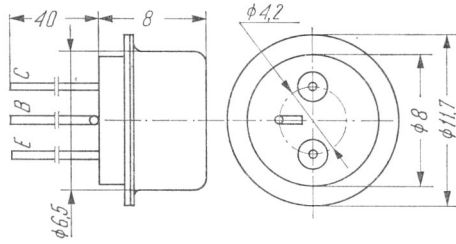


МП25



Rys. 1-1372. МП25

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: ZSRR

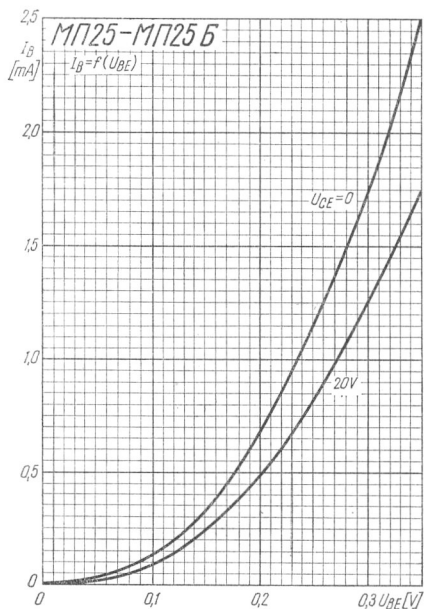
Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p małej mocy, w hermetycznej obudowie metalowej

Zastosowanie: układy wzmacniające i przełączające urządzeń powszechnego użytku

Typy podobne: АСУ17÷19, АСУ44, ОС123

Wartości charakterystyczne¹⁾

	МП25	МП25А	МП25В		
I_{CB0}	75	75	75	μA	przy $U_{CB \text{ max}}$
I_{EB0}	75	75	75	μA	przy $U_{EB \text{ max}}$
$U_{CE \text{ sat}}$	0,25	0,25	0,25	V	przy $I_C = 100 \text{ mA}$
$U_{BE \text{ sat}}$	1,2	1,0	1,0	V	przy $I_C = 100 \text{ mA}$
$r_{b'b}$	160	160	160	Ω	przy $U_C = 20 \text{ V}$, $I_E = 25 \text{ mA}$, $f = 500 \text{ kHz}$
$t_{p \text{ tot}}$	1,5	1,5	1,5	μs	przy $U_C = 30 \text{ V}$, $I_E = 25 \text{ mA}$
h_{21e}	13÷25	20÷40	30÷80		przy $U_C = 20 \text{ V}$, $I_E = 2,5 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ kHz}$
f_{h21b}	200	200	500	kHz	przy $U_C = 20 \text{ V}$, $I_E = 2,5 \text{ mA}$



Rys. 1-1373. Charakterystyki wejściowe

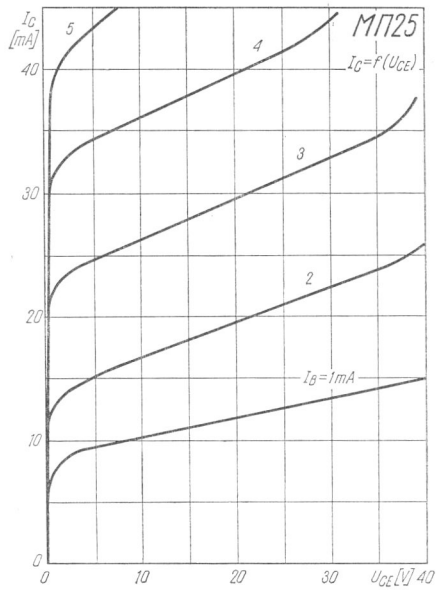
Wartości graniczne

$U_{CB0 \text{ max}}$	40	40	40	V
$U_{CB0 \text{ max}}^{2)}$	60	60	60	V
$I_{CM \text{ max}}$	300	400	400	mA
$P_C \text{ max}^{3)}$	200	200	200	mW
$t_j \text{ max}$	75	75	75	$^{\circ}\text{C}$
t_{amb}	-55 ÷ +60			$^{\circ}\text{C}$

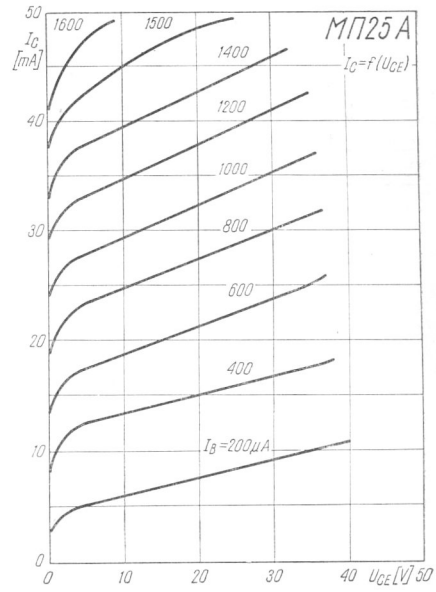
¹⁾ $t_{amb} = 20^{\circ}\text{C} (\pm 5^{\circ}\text{C})$

²⁾ $P_C < 100 \text{ mW}$, $t_{amb} \leq 50^{\circ}\text{C}$

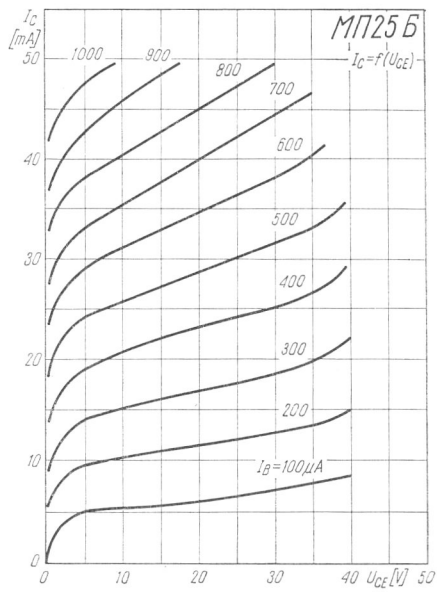
³⁾ $t_{amb} \leq 35^{\circ}\text{C}$



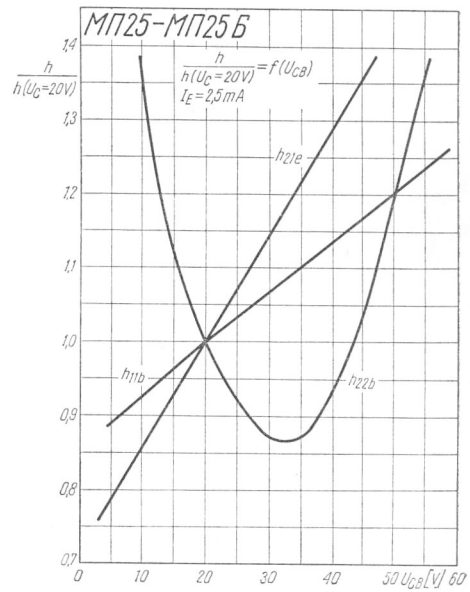
Rys. 1-1374. Charakterystyki wyjściowe



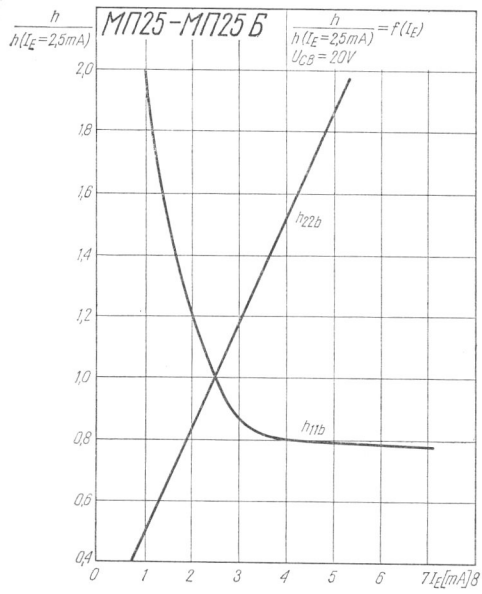
Rys. 1-1375. Charakterystyki wyjściowe



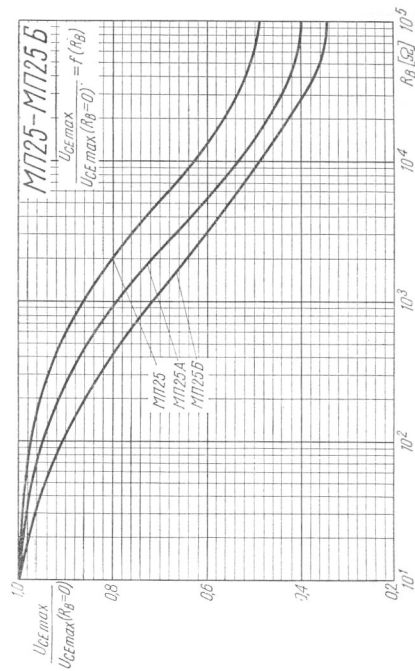
Rys. 1-1376. Charakterystyki wyjściowe



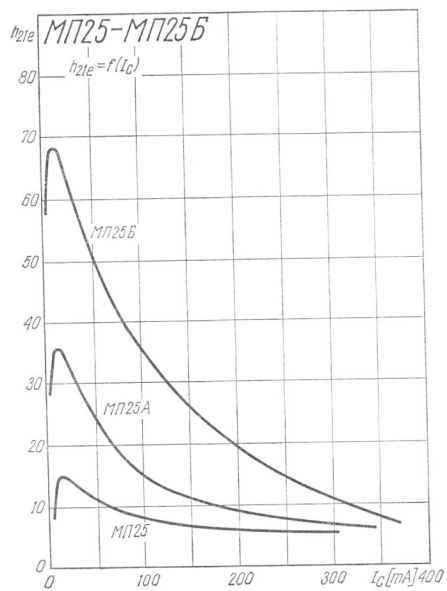
Rys. 1-1377. Zależność parametrów h od napięcia kolektor-baza



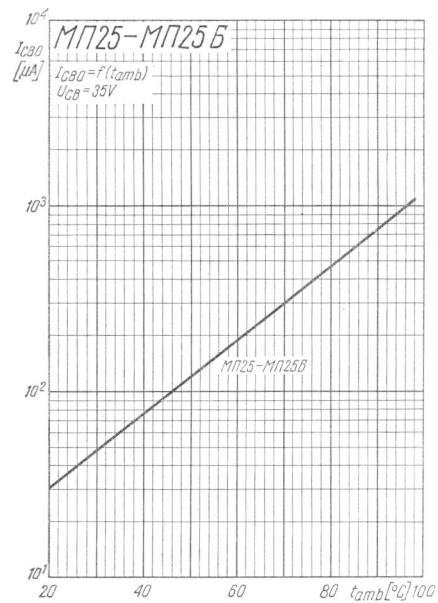
Rys. 1-1378. Zależność parametrów h od prądu emitera



Rys. 1-1379. Zależność napięcia przebicia kolektora od rezystancji bazy



Rys. 1-1380. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



Rys. 1-1381. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury otoczenia